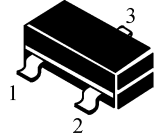




GMC945

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■ MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^{\circ}\text{C}$) 最大額定值

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V_{CBO}	60	Vdc
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V_{CEO}	50	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V_{EBO}	5.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	I_{c}	100	mA
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P_{C}	225	mW
Junction Temperature 結溫	T_{j}	150	$^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature Range 儲存溫度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$

■ DEVICE MARKING 打標

GMC945(C945LT1)=CR
HFE:120-220 200-400



GMC945

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

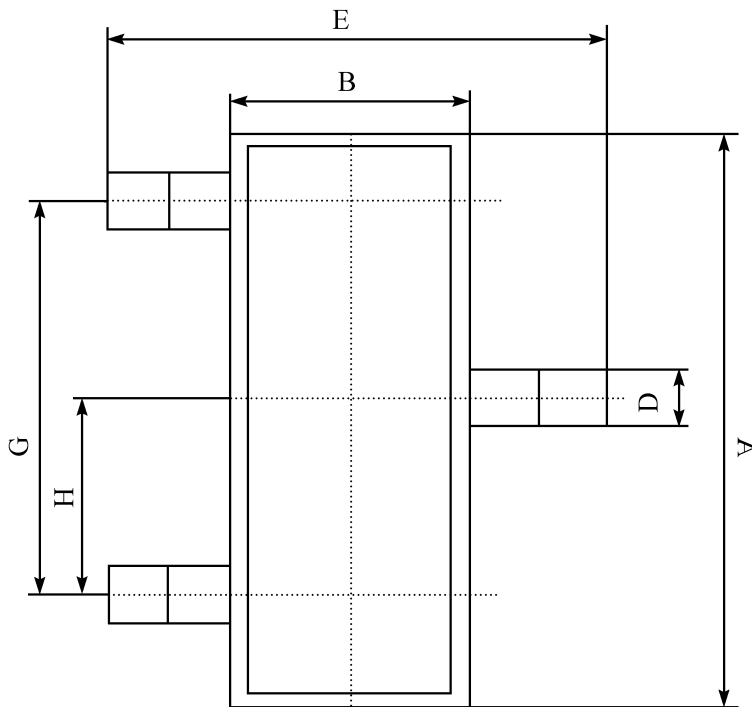
($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	$V_{CB}=60\text{V},$ $I_E=0$	—	—	0.1	μA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V},$ $I_C=0$	—	—	0.1	μA
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100\mu\text{A}$	60	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1.0\text{mA}$	50	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100\mu\text{A}$	5	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	H_{FE}	$V_{CE}=6\text{V},$ $I_C=1\text{mA}$	120	—	400	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA},$ $I_B=10\text{mA}$	—	—	0.3	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基極-發射極電壓	V_{BE}	$V_{CE}=5.0\text{V},$ $I_C=10\text{mA}$	—	—	0.8	V
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	$V_{CE}=6.0\text{V},$ $I_C=1\text{mA}$	—	250	—	MHz



GMC945

■DIMENSION 外形封裝尺寸



序號	數值及公差
A	2.90±0.10
B	1.30±0.10
C	1.00±0.10
D	0.40±0.10
E	2.40±0.20
G	1.90±0.10
H	0.95±0.05
J	0.13±0.05
K	0.00-0.10
M	≥0.2
N	0.60±0.10
P	7±2°

